

The Raw Silicon Wafer單晶矽片

3-inch mono crystal silicon N-type light doped wafer

3寸單晶矽N型輕摻矽片

電阻率Ω·CM	厚度μm	晶向	壽命μs	外徑mm	摻雜劑	形態				電阻率徑向不均勻性
						線切片	研磨片	倒角片	定位片	
5-10	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
10-15	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
15-20	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
20-25	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
25-30	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
30-35	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
35-40	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
40-45	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
45-50	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
50-55	200-350	<111>	>100	76.2±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%

4-inch mono crystal silicon N-type light doped wafer

4寸單晶矽N型輕摻矽片

電阻率Ω·CM	厚度μm	晶向	壽命μs	外徑mm	摻雜劑	形態				電阻率徑向不均勻性
						線切片	研磨片	倒角片	定位片	
5-10	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
10-15	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
15-20	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
20-25	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
25-30	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
30-35	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
35-40	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
40-45	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
45-50	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%
50-55	200-350	<111>	>100	101.6±0.3	磷	✓	✓	✓	✓	≤20%

3-inch mono crystal silicon heavy doped wafer

3寸單晶矽重摻矽片

電阻率Ω·CM	厚度μm	晶向	型號	外徑mm	摻雜劑	形態				電阻率徑向不均勻性
						線切片	研磨片	倒角片	定位片	
0.003-0.005	200-350	<111>	N/P	76.2±0.3	磷/硼	/	✓	✓	✓	/
0.005-0.008	200-350	<111>	N/P	76.2±0.3	磷/硼	/	✓	✓	✓	/
0.02-0.03	200-350	<111>	N/P	76.2±0.3	磷/硼	/	✓	✓	✓	/

4 inch monocrystal silicon heavy doped wafer

4寸單晶矽重摻矽片

電阻率Ω·CM	厚度μm	晶向	型號	外徑mm	摻雜劑	形態				電阻率徑向不均勻性
						線切片	研磨片	倒角片	定位片	
0.003-0.005	200-350	<111>	N/P	101.6±0.3	磷/硼	/	✓	✓	✓	/
0.005-0.008	200-350	<111>	N/P	101.6±0.3	磷/硼	/	✓	✓	✓	/
0.02-0.03	200-350	<111>	N/P	101.6±0.3	磷/硼	/	✓	✓	✓	/